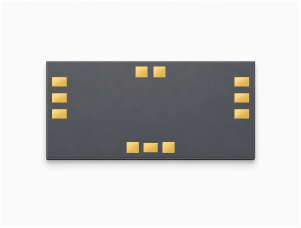
12000–18000 MHz GaN SPDT MMIC 스위치 베어 다이 — IL 1 dB (대표값)

LCI-SW-12000-18000-SPDT · 12000–18000 MHz · GaN SPDT MMIC 스위치 베어 다이.



RF 전기 특성표의 규격값: 삽입 손실 1 dB (대표값); 격리도 38 dB (대표값); P0.2dB 44 dBm (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C.

RF 포트에 외장 DC 차단 커패시터가 필요하지 않습니다.

V1 / V2: 100 pF; 10000 pF; 10 µF

다이 치수: 1.8 × 0.95 × 0.1 mm.

V1 (V) = -28; V2 (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2

V1 (V) = 0; V2 (V) = -28; RF = RFin ↔ RFout1

RF 특성 TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	12000	-	18000	MHz
삽입 손실	-	-	1	1.2	dB
격리도	-	36	38	-	dB
입력 0.2 dB 압축점 전력	-	-	44	-	dBm
입력 VSWR	-	-	1.5	-	-
출력 VSWR	-	-	1.5	-	-
스위칭 시간	-	-	10	-	ns

제어 전압

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
제어 전압 (V < 0)	-	-	-	-	-28	V
제어 전압 (0 V)	-	-	-	-	0	V

한계값 한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 입력 전력 [1]	-	-	-	45	dBm
보관 온도	-	-65	-	150	°C
동작 온도	-	-55	-	85	°C
게이트 바이어스 하한	-	-60	-	-	V

[1] CW

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	1.8 × 0.95 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±100	µm

본딩 패드 배치

핀 번호	기호	mm
1	RFin	0.120 × 0.080
2, 3	O1, O2	0.120 × 0.080
4, 5	V1, V2	0.100 × 0.100

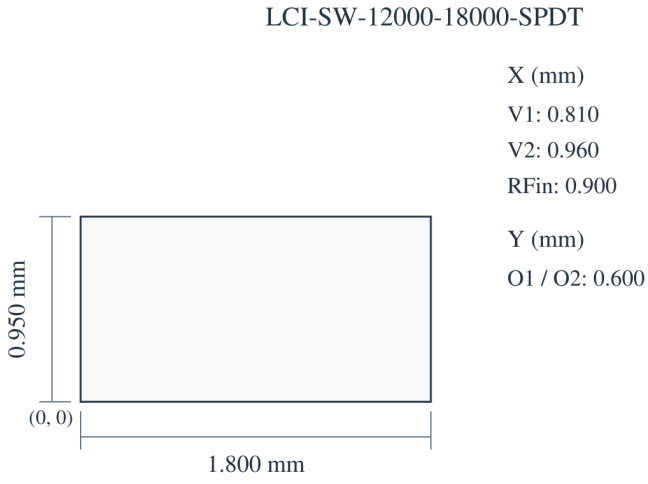
현재 발행 기록 · 1.7 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.6.

통합 설계 안내

RF 포트에 외장 DC 차단 커패시터가 필요하지 않습니다. V1 / V2: 100 pF; 10000 pF; 10 µF V1 (V) = -28; V2 (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2 V1 (V) = 0; V2 (V) = -28; RF = RFin ↔ RFout1

기구 외형도

외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.



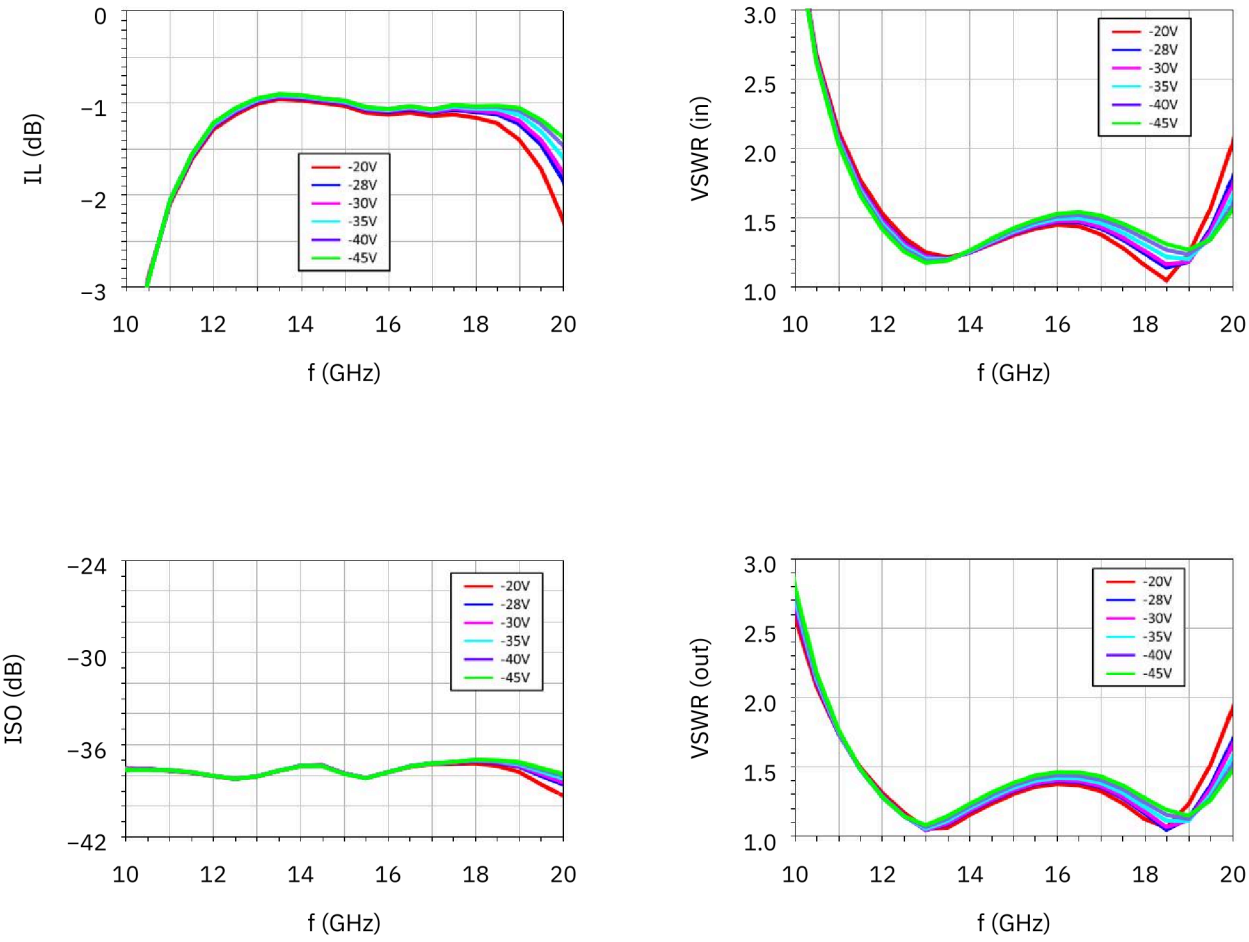
1.800 × 0.950 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

성능 특성 곡선

각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.

삽입 손실; 격리도; 입력 정합; 출력 정합.

그림 참고 사항: TA=+25°C. 범례에는 −20 / −28 / −30 / −35 / −40 / −45 V가 표시됩니다. 전압 노드는 규정되어 있지 않습니다.



−20 V −28 V −30 V −35 V −40 V −45 V

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.